カーボン分散ニッケルめっきの被膜構造と電気特性の関係

吉田 智博^{*1}, 中野 賢三^{*1}, 古賀 弘毅^{*1}

Relationship Between Film Structure and Electric Resistivity of Carbon Composite Nickel Plating Tomohiro Yoshida, Kenzo Nakano and Hiroki Koga

電気接点の需要は再生エネルギーや、IoTの拡大に伴い増加すると予測される。従来の電気接点には、金(以下、 Auという)めっき,ニッケル(以下、Niという)めっきやスズ(以下、Snという)めっきが用いられているが,価 格や酸化による抵抗値増加が課題であり化学的に安定で安価な電気接点が求められている。本研究では、めっき液 中に化学的に安定なカーボンを分散させ、めっき被膜成長と同時にカーボンを取り込む溶液分散系において、めっ き被膜構造と電気抵抗の関係について評価を行った。高温高湿環境での抵抗値増加の抑制には、粒径の小さなカー ボンを緻密に取り込んだ構造が有効であった。

1 はじめに

近年,水素エネルギーや太陽光発電などの再生エネ ルギー、地熱や工場排熱などの未利用エネルギーの有 効活用が進められている。これらエネルギー源を組み 合わせ, 自立型分散エネルギーシステムを構築し, ネ ットワークと組み合わせて統合的に制御するスマート エネルギーネットワークが進められており¹⁾,電力・ 通信での電気接点は増大が見込まれている。例えば, 二次電池や燃料電池での外部への接続端子、コネクタ などの電気接点,産業用の受配電盤や制御盤内部で高 電圧大電流の通電に用いる導体棒のブスバーに対し て、材料置換によるコスト低減が求められてる。

従来、図1に示すように小型の電気接点はAu/Niめ っき/Cu 母材が用いられていたが Au は高価である。 大型の電気接点には Cu 母材に対して Ni めっきや, Sn めっきが用いられていたが、耐食性が低いため Ni, Sn 共に表面に高抵抗の酸化膜が形成されて抵抗値が 上昇するという欠点があった²⁾。本研究では Au めっ きからのコスト低減, Ni, Sn めっきからの耐食性向 上を目的に、Ni めっき中にカーボン粒子を分散させ



た構造(図1右)を有する分散めっき被膜の開発を試 みた。

2 実験方法

本研究では、めっき液中にカーボンを分散させ、 めっき被膜成長と同時にカーボンをめっき被膜中に取 り込む溶液分散系で被膜形成を行った。表1に代表条 件を示す。めっき手法としては, 電気めっきと無電解 めっきで検討を行った。無電解めっきの分散剤は、ポ リエチレンイミン (PEI), ドデシル硫酸ナトリウム (SDS) を分散剤に用いた。カーボン粒子 (50 nm, 3 μm, 5 μm) は 3 種類の粒径について検討を行った. めっきサンプルの評価には, SEM を用いた表面, 断面 観察,抵抗値の評価には2探針法(定電流法)を用い た。高温高湿試験は温度 60°C, 湿度 90 %RH の条件 で120時間保持を行った。

項目	めっき条件・浴組成	
試験片·前処理	鋼板(20mm×60mm) 【前処理】 ・#1000相当工業用パッドで研磨 ・(1+1)塩酸浸漬、常温、1min ・鉄接触法によりめっき開始(無電解めっきの場合)	
電気めっき	めっき液	ワット浴
	カーボン	カーボンブラック(CB) 1次粒径 50nm
	分散剤	ポリエチレンイミン (PEI)
	浴温	60 °C
	陰極	銅板(20mm × 50mm)
	電荷量	240 C(電流密度 2A/dm ²)
	陰極	ニッケル板 20 × 50 mm
無電解めっき	めっき液	無電解Ni-Pめっき液
	カーボン	カーボンブラック(CB) 1次粒径 50nm カーボン粒子 3µm、5µm
	分散剤	ポリエチレンイミン (PEI)、 ドデシル硫酸ナトリウム (SDS)
	浴温	88 °C
	撹拌	バブリング

表1 カーボン分散 Ni めっきの条件

3 結果と考察

3-1 めっき手法による構造,電気特性の比較

図2にPEI(分子量1200)を1g/L,CB(粒径50nm)1 g/Lの条件でめっき液中に分散させためっき被膜の外 観を示す。電気めっきの方が黒く,無電解めっきは端 部で銅板の色がみられており,めっきの成長が阻害さ れた可能性がある。



図2 電気, 無電解めっき被膜の外観 (PEI(分子量1200)1g/L, CB(粒径50 nm)1 g/L, めっき時間2h)

図3に電気めっき,無電解めっき被膜の表面および 断面SEM像を示す。電気めっきの表面は,微細な粒子 が集合した形状が見られており,表面にカーボン粒子 の露出が見られなかった。断面SEM像では,めっき被 膜内部にカーボンが取り込まれていた。無電解めっき では表面にも,カーボンの黒点が見られた。断面SEM 像では,約150 nmの薄いNiめっき層がみられた。電気 めっきでは,電流を流すことでNiを還元して被膜を形 成するためカーボンを取り込んだ部分が突起となり, 電流集中が生じたことにより葡萄状に成長したと考え られる。無電解めっきでは還元剤から電子が供給され るため,局所的なめっき被膜の成長が起こらず平坦な 形状になったと考えられる。



図3 電気,無電解めっき被膜の表面,断面 SEM 像 (PEI(分子量1200)1 g/L, CB(粒径50 nm) 1 g/L,

無電解めっき時間2h)

図4に電気,無電解めっきの電気抵抗値を示す。無電 解めっきと比較して、電気めっきは低い抵抗値を示し た。材料固有の導電率を比較すると,Cu 5.81×10⁷ S/m (293K),Ni 1.45×10⁷ S/m (293 K)でCuの抵抗値 が低い³⁾。一方,Niめっき被膜の文献値の抵抗値比較 では電気Niめっき 8.5 $\mu\Omega$ ・cm,無電解Ni-Pめっき 30 ~200 $\mu\Omega$ ・cmで,電気Niめっきの抵抗値が低い⁴⁾。無 電解Ni-Pめっきのようにめっきが薄い場合でも,固有 抵抗の低いCu板より抵抗値の高い無電解Ni-Pめっき被 膜自身による抵抗への寄与が大きいと考えられる。



図4 電気・無電解めっき被膜の抵抗値 (PEI(分子量1200)1 g/L, CB(粒径50 nm) 1 g/L)

3-2 PEIの分子量と構造, 電気特性の比較

図5に, PEIの分子量を10000, 1200, 600, 300 (濃 度50 mg/L), CB 1 g/Lの条件で作製したカーボン分散 無電解Ni-Pめっきの表面SEM像を示す。分子量の大き いサンプル (10000, 1200, 600) では, 前処理の研磨 跡がみられておりNi-Pめっきの成長が阻害された。分 子量300では研磨痕は不明瞭となり, カーボンが分散 された被膜が形成された。



図 5 PEI の分子量の異なる無電解 Ni-P めっきサンプルの表面 SEM 像 (PEI(分子量 300~1200)50 mg/L, CB(粒径 50 nm) 1 g/L, めっき時間 2h)

図6に分子量300のPEIの無電解Ni-Pめっきの断面SEM を示す。膜厚は約1.3 μmで図3の分子量1200の膜厚 (約150 nm)よりも増加しており,分散剤濃度および 分子量の低減により,分散剤によるめっき成長阻害を 抑制できた。図7に分子量300~10000の無電解Ni-Pめ っきの抵抗値を示す。抵抗の平均値は0.035~0.045 Ωで,分子量による差は見られなかった。



図 6 PEI (分子量 300)無電解 Ni-P めっきの 断面 SEM 像



図7 PEI(分子量300~1200)での無電解Ni-P めっきの電気抵抗値 (PEI(分子量300~1000)50 mg/L, CB(粒径50 nm)1 g/L, めっき時間2h)

3-3 カーボン分散状態と電気特性の比較

図8にカーボンの分散状態の異なる無電解Ni-Pめっ きの高温高湿試験前後の表面SEM像を示す。各条件は 分散状態の安定化のため、PEI 50 mg/LにSDSを追加し、 SDSの濃度を10~35 mg/Lとした。試験後、カーボンの 取込量が少ない、SDS 10 mg/Lおよび50 mg/LではNi粒 界、半球状のノジュール周辺が黒く変色した。カーボ ンが比較的均一に分散されたSDS 25 mg/Lのサンプル は、高温高湿試験後のサンプル表面に変色はなかった。

図9にカーボンの分散状態の異なる無電解Ni-Pめっ き (SDS 10~50 mg/L) の電気抵抗値を示す。高温高 湿試験前の抵抗の平均値は約0.04~0.08 Ωであった が,高温高湿試験後では0.06~0.2 Ωに増加している。 増加の大きいSDS 10 mg/Lでは2.7倍,増加の小さい SDS 25 mg/Lでは1.26倍であり,カーボン粒子の取込 が多いことにより,高温高湿環境下でNiめっき表面に 抵抗値が高い酸化層が形成されても,化学的に安定な カーボンが通電経路になることで,低い抵抗値を維持 したと考えられる。



図 8 SDS (10~50 mg/L) の無電解 Ni-P めっきの表面 SEM 像 (PEI (分子量 300) 50 mg/L, CB (粒径 50 nm) 1 g/L, めっき時間 2h)



図 9 PEI (分子量 300~1200) での 無電解 Ni-P めっきの電気抵抗値 (PEI(分子量 300)50 mg/L, CB(粒径 50 nm) 1 g/L, めっき時間 2h)

3-4 カーボン粒径と電気特性の比較

図10にカーボン粒径50 nm, 3 µm, 5 µmのカーボン 分散無電解Ni-Pめっきの表面SEM像を示す。分散剤に はPEI(分子量300)を用い,カーボン50 nmの最適条 件をベースに各粒径の表面積で規格化した濃度で実施 した。粒径50 nmのカーボンでは緻密に取り込めてい るが,3 µm,5 µmでは分布にバラつきがあった。SEM 像を二値化し黒色部分をカーボンとして計算したカー ボン比率では,カーボン粒径5 μmが最も高く,50 nm, 3 μmの順で減少した。



図 10 カーボン粒径 50 nm~5 µm の無電解 Ni-P めっきの表面 SEM 像 (カーボン粒径 50 nm 1 g/L, PEI (分子量 300) 50 mg/L, カーボン粒径 3 µm 1 g/L, PEI (分子量 300) 41.5 mg/L, カーボン粒径 5 µm 1 g/L, PEI (分子量 300) 25 mg/L,

めっき時間 2h

図11に粒径50 nm, 3 µm, 5 µmのカーボン分散無電 解Ni-Pめっきの高温高湿試験前後の抵抗値を示す。試 験後では抵抗値の上昇がみられるが,粒径50 nm, 5 µm, 3 µmの順で抵抗上昇が抑制された。前掲図10で 示したSEM像から求めた各粒径でのカーボン比率と抵 抗値上昇に単純な相関はみられなかった。図12にカー ボン分散めっきが高温高湿試験後に酸化被膜を形成し たときの電気抵抗のイメージを示す。めっき上面では, 酸化層とカーボンの並列抵抗を形成すると仮定すれば, 酸化層よりもカーボンの抵抗値が低いため,カーボン 量が多い方が全体の合成抵抗は低くなると考えられる。





ー方で、図13に示すカーボン粒径と電気抵抗のイメー ジのように、カーボン粒子が大きい場合、相手電極と の接点が減少し全体のカーボン粒子でみたときの電流 が流れる面積が減少すると考えられる(図13左図)。 粒子が小さい場合には、接点が増加し、カーボン粒子 全体での抵抗値が減少したと推定される(図13右図)。 従って、高温高湿環境下で酸化Ni層が形成した状態で は、カーボン比率と接地面積の2つの要素で抵抗値の 上昇が低減されていると考えらる。今回検討した粒径 とカーボン分布では、50 nmのサンプルで抑制効果が あったと考えられる。



図 12 高温高湿試験後のカーボン分散めっきの 電気抵抗イメージ



図 13 カーボン粒径の違いによるカーボン 分散めっきの電気抵抗イメージ

4 まとめ

めっき液中にカーボン粒子を分散させ,被膜形成と 同時に取り込む溶液分散系でのカーボン分散めっきに ついて,めっき手法,分散剤の分子量,カーボンの取 込量,カーボン粒径において,めっき被膜構造と電気 抵抗の関係を評価した。電気めっきではカーボン粒子 の表面への露出がみられず,カーボンを接点とする場 合は無電解めっきが適していた。カーボンのめっき液 中での分散性向上を目的に添加した分散剤は分子量, 添加量の増加に伴い,めっき成長を阻害する可能性が 示唆された。高温高湿環境で,めっき被膜の電気抵抗 上昇の抑制には,粒径が小さく,緻密に取り込んだめ っき被膜が有効であった。

5 参考文献

- 1) 工月亮太: 日本不動産学会誌, 第26巻, 第1号, p104 (2012)
- 2) 榎本英彦: 金属表面技術, Vol. 33, No. 7, p341 (1982).
- 3) 日本金属学会編:金属便覧,改定6版, p633, 丸善(2000)
- 4) 黑坂成吾, 佐藤誠, 表面技術, Vol 65, No. 3, p118 (2014)